


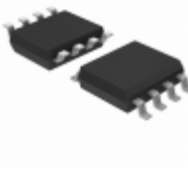





	<h2 style="color: red;">SI4108DY-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4108DY-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 75V 20.5A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4108DY-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 12315 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI4108DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 20.5A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	12315 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 75V 20.5A (Tc) 3.6W (Ta), 7.8W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	3.6W (Ta), 7.8W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.8 mOhm @ 13.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	54nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2100pF @ 38V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI4108DY-T1-GE3DKR

SI4108DY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI4108DY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4108DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4108DY-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI4108DY</b> Vishay Precision Group SI4108DY VISHAY</p>	 <p><b>SI4112-BM</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC SYNTHESIZER IF-ONLY 28MLP</p>	 <p><b>SI4110DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 80V 17.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4110DY-T1-E3</b> Vishay Precision Group SI4110DY-T1-E3 VISHAY</p>
 <p><b>SI4104DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 4.6A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4110DY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 80V 17.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4104DY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 4.6A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4104DY-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 4.6A 8-SOIC</p>

### heiße Teile

Mehr

SI4021-A1-FTR	SI4022-A0-FTR	SI4022-A1-FTR	SI4030-A0-FM	SI4032-V2-FMR
SI4033-B2-FM	SI4048DY-T1-E3	SI4056DY	SI4056DY-T1-E3	SI4056SPG
SI4058DY	SI4090DY	SI4100BDDY-T1-GE3	SI4100DY	SI4100DY-T1-E3
SI4100DY-T1-E3	SI4100DY-T1-GE3	SI4100DY-T1-GE3	SI4102DY	SI4102DY-T1-E3
SI4102DY-T1-E3	SI4102DY-T1-GE3	SI4102DY-T1-GE3	SI4104DY-T1-GE3	SI4104DY-T1-GE3
SI4108DY-T1-GE3	SI4110DY-T1-GE3	SI4110DY-T1-GE3	SI4112-D-GM	SI4113-BMR
SI4114DY	SI4114DY-T1-E3	SI4114DY-T1-E3	SI4114DY-T1-GE3	SI4114DY-T1-GE3
SI4116DY	SI4116DY-T1-E3	SI4116DY-T1-E3	SI4116DY-T1-GE3	SI4116DY-T1-GE3
SI4122-BTR	SI4122-D-GMR	SI4122DY-T1-E3	SI4122G-BMR	SI4123-BM
SI4124DY-T1-E3	SI4124DY-T1-E3	SI4124DY-T1-GE3	SI4124DY-T1-GE3	SI4126-BMR

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited